份日本国特許庁(JP)

⑩特許出順公開

母公開特許公報(A) 平4-104158

Øint. Cl. *

識別記号

庁内整理番号

@公開 平成4年(1992)4月6日

G 03 F 7/16

7818-2H

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全3頁)

公発明の名称 フオトレジスト襲形成方法

分符 顧 平2-221552

69出 篇 平2(1990)8月23日

宛発明者 井谷 俊郎

東京都港区芝5丁目7番1号 日本電気株式会社内

创出 順 人 日本電気株式会社 東京都港区芝5丁目7番1号

120代理人 弁理士内原 晋

4 4 8

3日の大学

フォトレジスト観形成方法.

特許請求の範囲

フォトレジストを半導体基板に満下し、その半導体基板をカップ内で囲転させフォトレジスト類を形成する方法において、そのカップ室内を育記フォトレジストの溶剤な器気にすることを特徴とするフォトレジスト製形成方法。

発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本売明は、半導体集積回路製造方法におけるフォトレジスト製形成方法に関する。

〔従来の技術〕

従来、この種のフォトレジスト襲形成方法は、 半導体基度 (以下、ウェーハとよぶ) にフォトレ ジスト液を消下し、ウェーハを高速回転させ、ウ ェーハ面に一根なフォトレジスト製を形成し、その遠心力により製の均一化を図っていた。また、このウェーハが回転するとき、ウェーハの周囲の雰囲気については、加速器で水底気容囲気にするかあるいは何も制御を行なわなかった。

(発明が解決しようとする課題)

背周平4-104158(2)

トレジストパターンの寸法句一性が低下するという欠点がある。特に、数値パターン形式に対しては、このようなフォトレジスト級軍の不均一性に起因するフォトレジストパターンのウェール署内不均一性は数合的である。

本売明の目的は、かかる欠点を解析し物一なフォトレジスト膜が形成されるフォトレジスト膜が 成方法を提供することである。

【無理を解決するための手段】

本発明のフォトレジスト展形成方法は、フォトレジストを中等体基板に接下し、その中等体基板をカップ内で開版させフォトレジスト展を形成する方法において、そのカップ室内を背配フォトレジストの推開学団気にすることを特徴としている。

(実施例)

次に、本元明について理論を参照して説明する。

第1回は本売明の一変施供のフォトレジスト製 形成方法を説明するためのレジスト製造布装置の 上記方法では、センサー212によりカップ室 206内の専制学団気を常時感知し、制御部21 3によりヒーター210を制御し、無せされる排 剤211の蒸気の量を制御できるため、その該果 カップ室206内の推測学団気をより正確に制御 することができる利点がある。

(発明の効果)

以上説明したように本先明は、ウェーハにフォ トレジストを摘下し、ウェーハを回転処理するカ ップ室内を、フォトレジスト祭に含まれるMEK (メチルエチルケトン)、ECA(エチルセロソ ルプアステート)等の溶剤雰囲気にさせることに よって、フォトレジストが適下され回転している ウェーハ上に形成されつつあるフォトレジスト質 から推発する複列の量を制御できる方法となって いる。その結果、フォトレジストが適下され回転 しているウェーハ上に形成されつつあるフォトレ ジスト襲から揮発する溶剤の量を朝鮮でき、フォ トレジスト裏内部から揮発する格別の量がウェー 八面内で異なるということはなくなり、フォトレ ジスト異年のウェーハ面内均一性が向上するた め、露光、現象形成されるフォトレジストパター ンの寸法均一性は著しく向上するフォトレジスト 豊形成方法が得られるという効果がある。

因面の簡単な説明

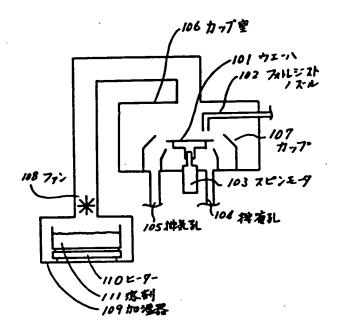
第1因は本先明の一実施例のフォトレジスト票

持局平4-104158(3)

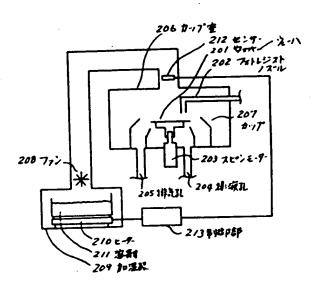
形成方法を説明するためのレジスト製造布製製の 模式製画館、第2間は本売明の他の実施例のフォ トレジスト製形成方法を説明するためのレジスト 製造布装置の模式製画館である。

101.201…ウェーハ、102、202…フォトレジストノズル、103.203…スピンモーター、104.204…券最孔、105.205…俳気孔、106.206…カップ室、107.207…カップ、108.208…ファン、109.209…加速器、110.210…セーター、111.211…指列、212…センサー、213…制御器。

代理人 弁理士 内 原



第1四



第 2 图